# GA5210P 芯片规格书 (Ver 1.1)

### ♦ 介绍

#### 概述

- ◆ GA5210P 采用 CMOS 工艺制造,是专 为多士炉开发的高性价比专用集成电 路;
- ◆ GA5210P的 Reheat 和 Defrost 管脚内置 上拉电阻,外接元件更少;
- ◆ 芯片采用 DIP-8 封装。

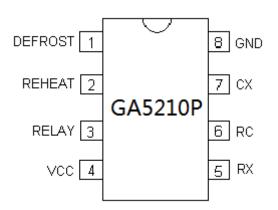
#### 特点

- ◆ 芯片工作电压 3.0V~5.0V;
- ◆ 支持单面、双面烤两种加热模式;
- ◆ 芯片具有温度补偿功能;
- ◆ 多士炉的定时时间由外接管脚的电阻 和电容决定,定时范围宽,用户可以根据自身的需要进行调整。

#### 应用

多功能多士炉。

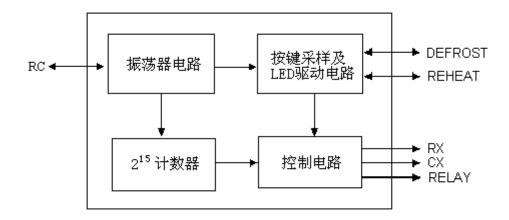
#### ♦ 管脚图



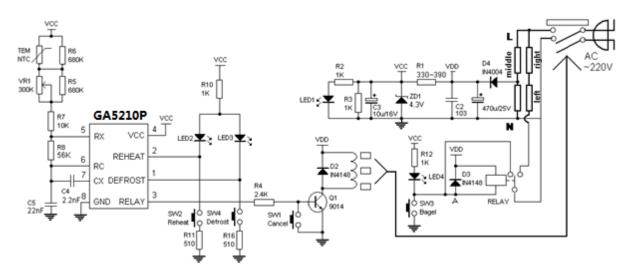
## ♦ 管脚说明

No.	管脚名	方向	功能说明				
1	DEFROST	I/O	输入负脉冲启动"解冻"功能。作输出时,用于"解冻"LED指示。				
			当C4=2.7n时,延长定时时间的百分比C4/C5,为10%,DEFROST				
			和REHEAT互锁。				
2	REHEAT	I/O	输入负脉冲启动"再加热"功能。作输出时,用于"再加热"LED				
			指示。加热时间由R8、C5决定。				
3	RELAY	О	当下压键按下时,该管脚输出高电平,驱动电磁铁吸合;定时结				
			束,该管脚输出低电平,电磁铁断开。				
4	VCC		电源。				
5	RX	О	当"再加热"引脚出现有效负脉冲时,短接到VCC。				
6	RC	I/O	振荡器输入/输出。				
7	CX	О	当"解冻"引脚出现有效负脉冲时,短接到GND。				
8	GND		接地。				

### ◇ 功能框图



#### ◇ 应用电路



说明: [1] 建议 R8 的取值大于  $30k\Omega$ ; [2] 建议 C5 的取值小于 56nF; [3] VDD 的设计参考电压为  $9V\sim16V$ ; [4] VCC 的电压为  $3V\sim5V$ 。

#### 定时时间(T)的近似计算公式:

◆ "加热再"模式:

 $T = 23640 \times R8 \times C5$ 

例: 如 R8=56kΩ、C5=22nF,则 T=30s

◇ "正常烤"模式:

T=23640×Rtotal×C5 其中, Rtotal= (RT1//R6) + (VR1//R5) +R7+R8。

RT1 是热敏电阻; VR1 是可调电阻; R6、R5、R7 用于调节定时时间或电路保护。

◆ "解冻"模式:

 $T=23640\times Rtotal\times (C5+C4)$ 

例:如 C4 = C5×10%,则解冻定时是在正常烤定时的基础上,延长 10%。

### 定时时间(T)与RC脚(PIN6)震荡频率之间的关系:

T=1/F×30×1024 F为RC脚频率,可以依据该公司精确计算定时时间。

当电源电压为 4.3V,震荡电阻取 47Kohm,电容取 27nF,震荡频率的中心点在 1024Hz 附近。一般情况下,使用同一测试条件,频率正负偏差在 5%以内可以判定芯片为合格品。

### ◇ 绝对最大限值

储存温度	-40°C to +125°C
工作时环境温度	0°C to +85°C
电源电压	2.8V ~ 5.5V
直流输出电流	20mA
功耗	500mW

## ♦ 推荐工作条件

Sym	Description	Min	Тур	Max	Units
Vcc	Supply Voltage	3.0	4.3	5.0	V
$V_{\text{IH}}$	Input High Voltage	$0.8 V_{\rm CC}$	-	-	V
VIL	Input Low Voltage	0	-	0.3Vcc	V
TA	Operation Temperature	0	25	85	$^{\circ}$

## ♦ 封装类型

封装类型: DIP-8